



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H8050

对应国外型号  
SS8050

## 主要用途

作便携式收音机 B 类推挽输出 2W 放大。

## 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极耗散功率.....	1W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	40V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	25V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	6V
$I_C$ ——集电极电流.....	1.5A

## 外形图及引脚排列

TO-92



- 1 发射极, E
- 2 基 极, B
- 3 集电极, C

## 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=35\text{V}, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}$	直流电流增益	85 40		500		$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}$ $V_{CE}=1\text{V}, I_C=800\text{mA}$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通电压			1	V	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=10\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_C=800\text{mA}, I_B=80\text{mA}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=800\text{mA}, I_B=80\text{mA}$
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_C=2\text{mA}, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
$f_T$	特征频率	100			MHz	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$

## 分档及其标志

B	C	D	E
85—160	120—200	160—300	270—500